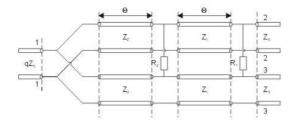
# 1. Zadanie 14

### 1.1. Treść

Zaprojektować dwusekcyjny, trój<br/>wrotowy dzielnik sygnału mikrofalowego obciążony od strony wejścia rezystancją<br/>  $Z_{01}=35~\Omega$ . Wrota wyjściowe tego dzielnika są obciążone rezystancjami<br/>  $Z_{02}=Z_{03}=50~\Omega$ , odpowiednio. Projekt wykonać, przy założeniu, że środkowa częstotliwość pasma pracy<br/>  $f_0=1.35~GHz$ . Wyznaczyć częstotliwościowe charakterystyki dopasowania we wrotach wejściowych WFS(f) i izolacji (separacji) pomiędzy wrotami I(f)[dB] w paśmie od  $f_1=1.25~GHz$  do  $f_2=1.45~GHz$ .



Rysunek 1.1: Schemat elektryczny dzielnika

### 1.2. Rozwiązanie

## 1.2.1. Projekt dzielnika

Projektowany dzielnik jest przedstawiony na rys. 1.1. Ze względu na różne impedancje obciążenia i źródła dzielnik musi transformować impedancje. Przyjmując  $Z_0=50~\Omega=q\times Z_0$ , stąd q=0.7.

Impedancję sekcji dzielnika są opisane zależnościami:

$$Z_1 = Z_0 \times V_1 \tag{1.1}$$

$$Z_2 = Z_0 \times V_2 \tag{1.2}$$

gdzie:

$$V_1^2 = \sqrt{C^2 + 2q} + CV_2 \qquad = \frac{2q}{V_1^2}C = \frac{(2q - 1)u_0^2}{2(2 - u_0^2)}u_0 \qquad = \sin\left(\frac{w\pi}{4}\right)w = \frac{2(f_2 - f_1)}{f_1 + f_2}$$
(1.3)

Dla danych z treści zadania otrzymuje się:

 $Z_1 = 54.4190599649 \ \Omega$ 

 $Z_2 = 64.3157011947 \ \Omega$ 

Rezystory separujące oblicza się z zależności:

$$R_2 = \frac{2Z_1 Z_2}{\sqrt{(Z_1 + Z_2)(Z_2 - Z_1 \operatorname{ctg}^2(\theta_3))}}$$
(1.4)

$$R_{2} = \frac{2Z_{1}Z_{2}}{\sqrt{(Z_{1} + Z_{2})(Z_{2} - Z_{1}\operatorname{ctg}^{2}(\theta_{3}))}}$$

$$R_{1} = \frac{2R_{2}(Z_{1} + Z_{2})}{R_{2}\frac{Z_{1} + Z_{2}}{Z_{0}} - 2Z_{2}}\theta_{3}$$

$$= \frac{\pi}{2}\left(1 - \frac{2}{2\sqrt{2}}\right)$$
(1.4)

co daje wynik:

$$R_2 = 80.3347745707 \ \Omega$$
  
 $R_1 = 307.005233567 \ \Omega$ 

#### 1.2.2. Charakterystyki dzielnika

W celu wyznaczenia charakterystyki częstotliwościowej dopasowania we wrotach wejściowych:

$$WFS(f) = \frac{1 + |S_{11}|}{1 - |S_{11}|} \tag{1.6}$$

Izolację z kolei określa zależność:

$$I(f) = 20\log\left(\frac{1}{|S_{23}|}\right) \tag{1.7}$$

Niezbędne parametry macierzy rozproszenia S:

$$S_{11} = \frac{-RN + jXN}{RD + jXD} \tag{1.8}$$

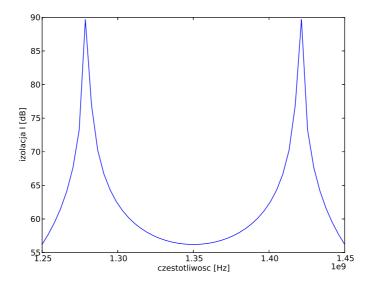
$$S_{11} = \frac{-RN + jXN}{RD + jXD}$$

$$S_{23} = \frac{1}{2} \left[ \frac{RN + jXN}{RD + jXD} - S_{22}^{+-} \right]$$
(1.8)

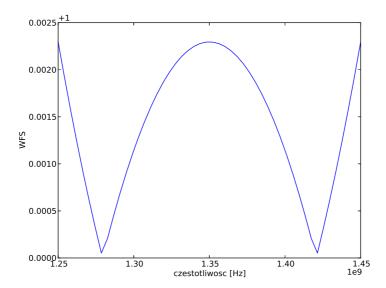
$$S_{22}^{+-} = \frac{A+jB}{C+jD} \tag{1.10}$$

(1.11)

Dokładne zależności podane zostały w [?]. Charakterystyki dzielnika zaprezentowano na rys. 1.2 i 1.3.



Rysunek 1.2: Charakterystyka izolacji dzielnika



Rysunek 1.3: WFS na wejściu dzielnika